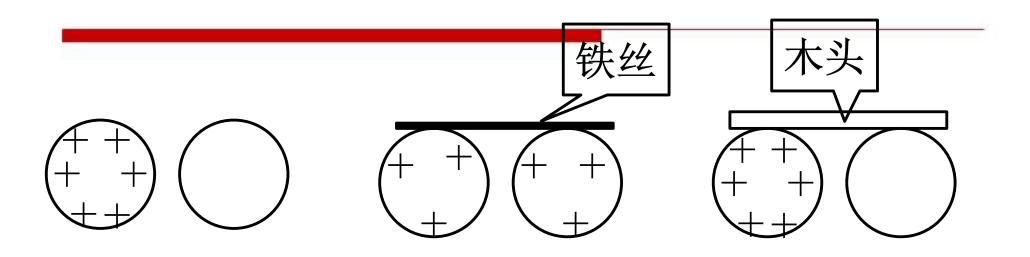
第13章 静电场中的导体和电介质

- §13.1 静电场中的导体
- §13.2 静电场中的电介质
- §13.3 电位移矢量 有电介质时的高斯定理
- §13.4 电容器的电容
- §13.5 电场能量

导体、绝缘体和半导体



导体	绝缘体	半导体
一些电子可以自	所有电子均被原	介于二者之间
曲移动	子核紧紧束缚	
主要是金属材料	其它大部分材料	少量材料

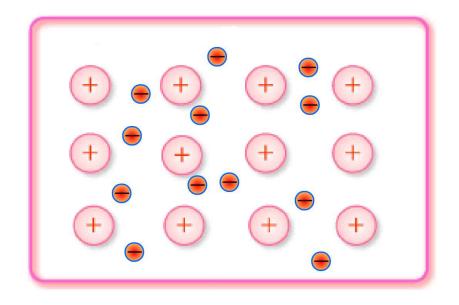
§ 13.1 静电场中的导体

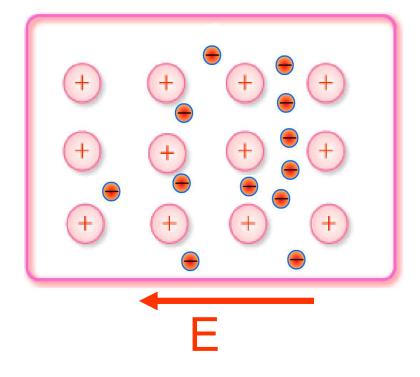
- 为什么要讨论静电场中的导体?
- 前一章主要讨论的是真空中的静电场,事实上,真是的世界不可能只存在静止电荷,还存在着各种物质。根据各种物质在静电场中的表现出的性质,可以将物质分为导体、半导体和绝缘体。
- 最常见的导体: 导线, 仪器金属外壳。

本讲基本要求

掌握静电平衡下导体的性质。掌握静电屏蔽。

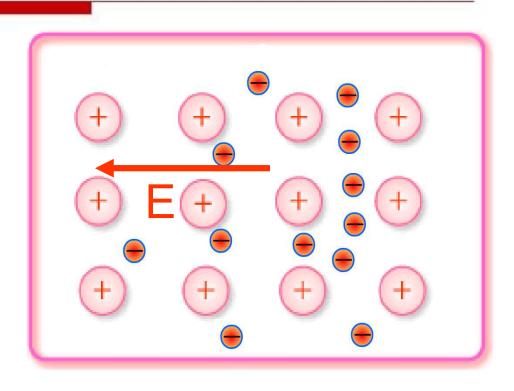
§ 13.1 静电场中的导体





13.1.1 导体的静电平衡条件

• 静电平衡



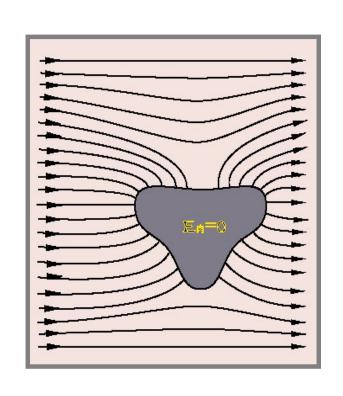
静电平衡状态: 导体内部和表面上任何一部 分都没有电荷的宏观定向运动

13.1.1 导体的静电平衡条件

(1)
$$E_{\bowtie} = 0$$

导体是等势体,表面是等 势面。

导体外表面附近的电场强度处处与导体表面垂直。

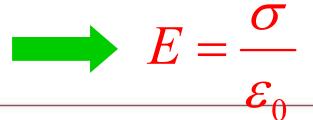


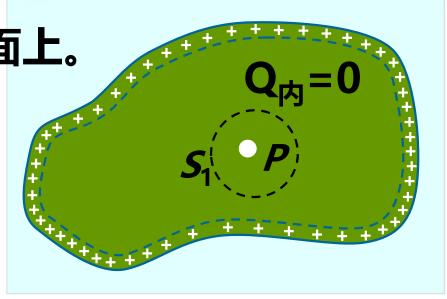
13.1.2 静电平衡导体上电荷的分布

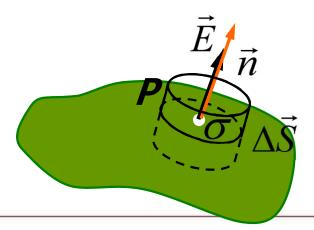
(2)净电荷只能分布在导体表面上。

导体表面上某点的面 电荷密度与该点电场强 度的大小成正比

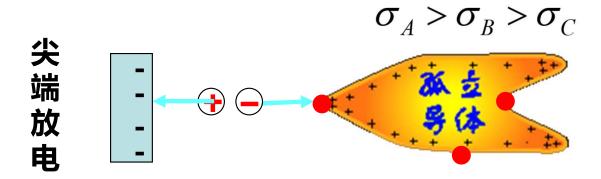
$$\Phi_e = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot \Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\varepsilon_0}$$

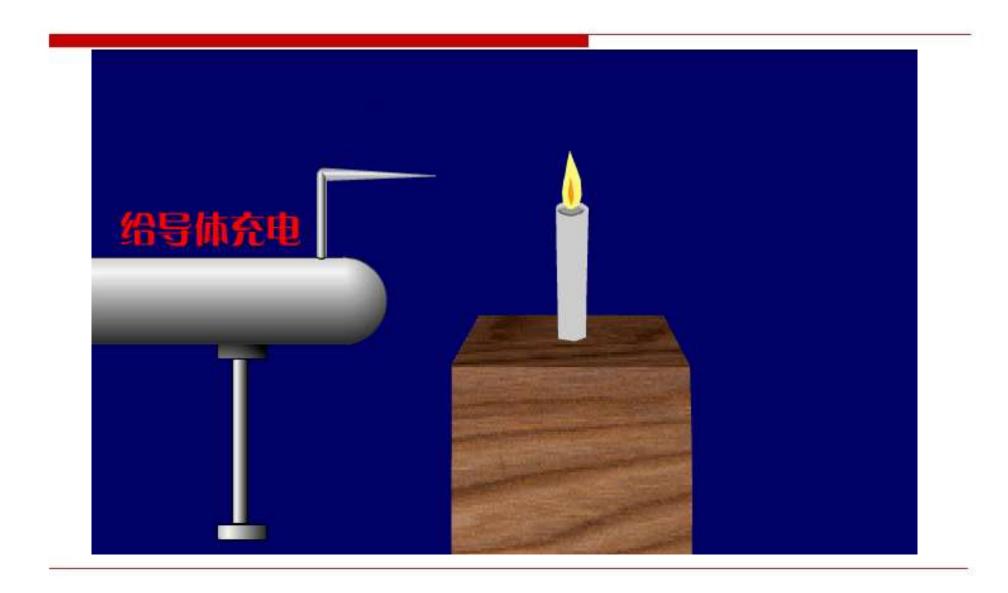




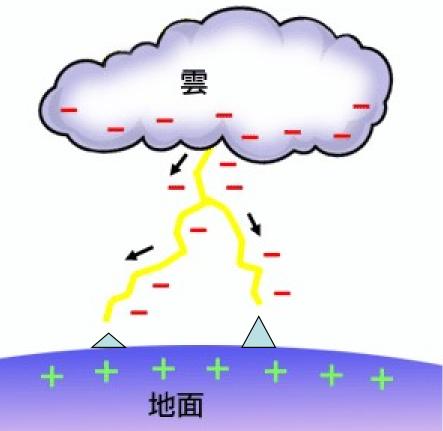


(3) 电荷面密度与导体表面的曲率有关





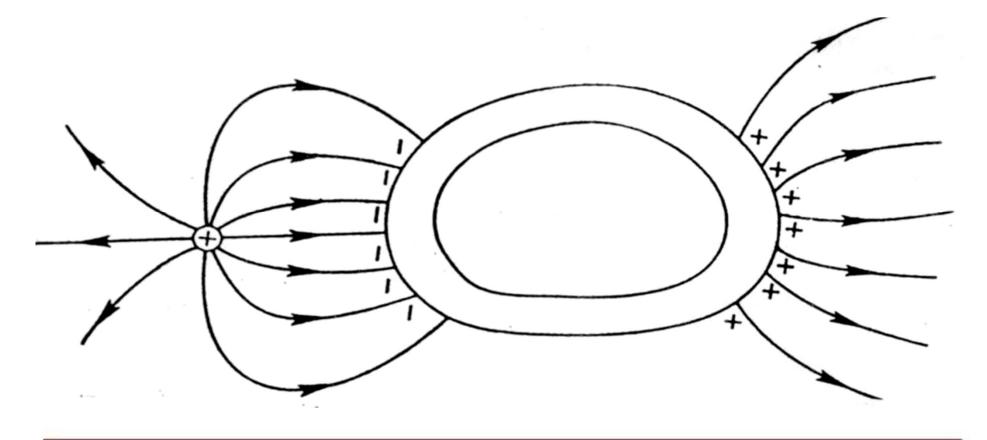




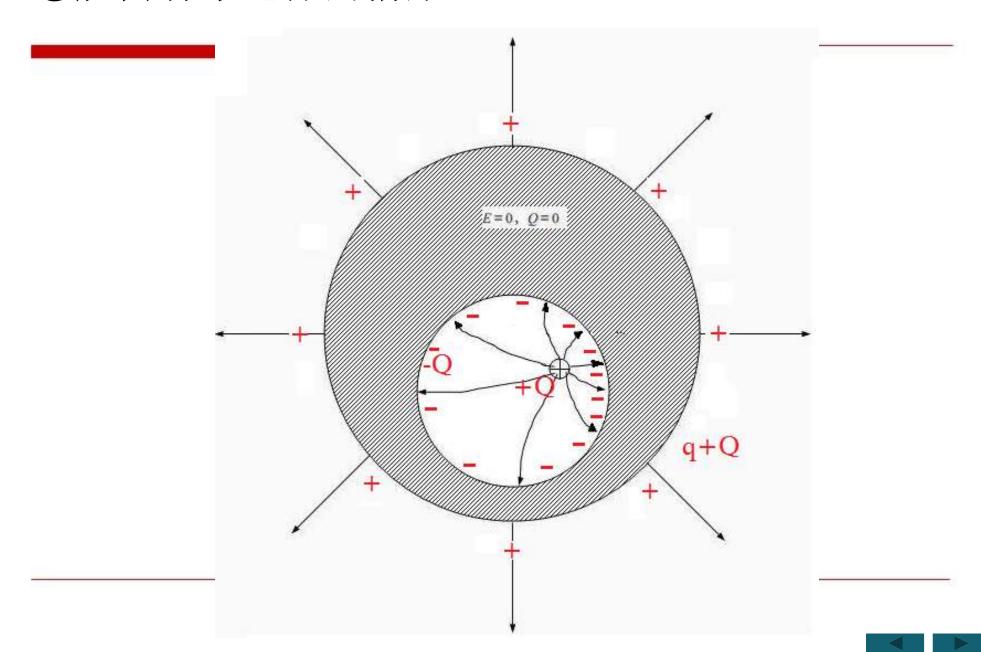
13.1.3 导体空腔与静电屏蔽

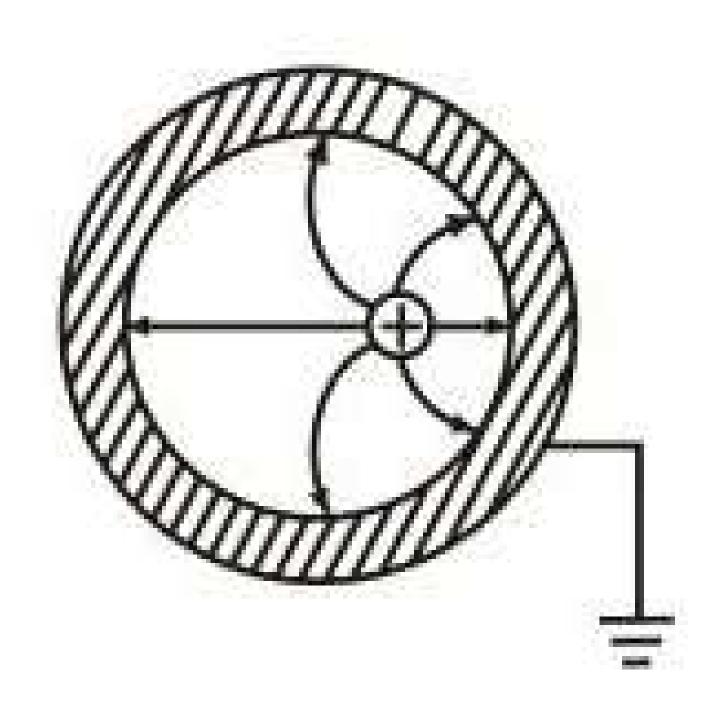
1.导体空腔的静电平衡特性

①腔内无带电体的情形。

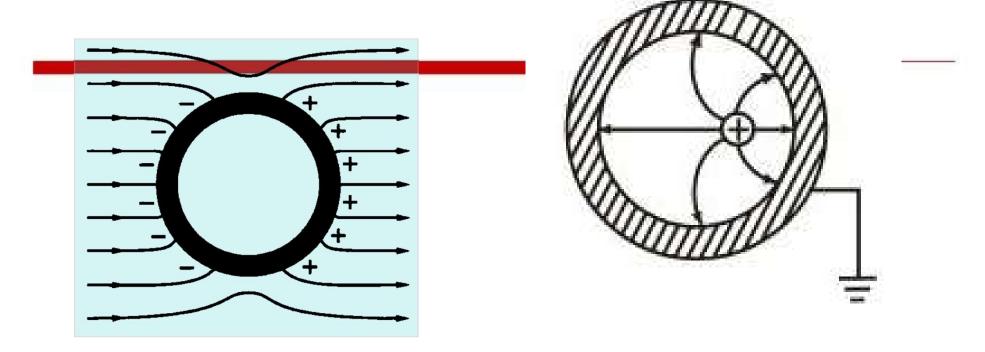


②腔内有带电体的情形。





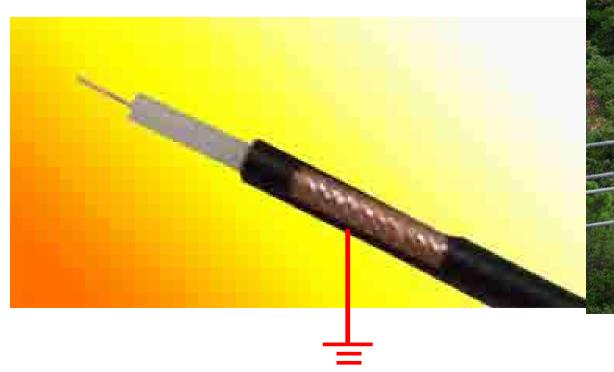
2 静电屏蔽



(腔内的物体不受 外界电场的影响)

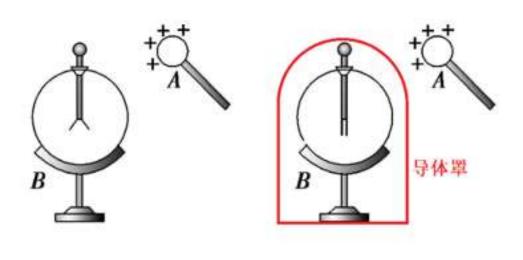
(内外隔绝)

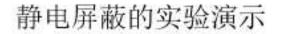
利用导体的静电平衡特性,使局部空间不受电场影响的现象叫做静电屏蔽





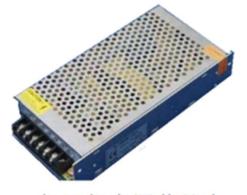
导电纤维织成的均压服







静电屏蔽袋



仪器仪表屏蔽外壳

例 两块等面积的金属平板 ,分别带电荷 q_A 和 q_B ,平板面积均为S ,两板间距为d ,且满足面积的线度远大于d。

求静电平衡时两金属板各表面上的电荷面密度。

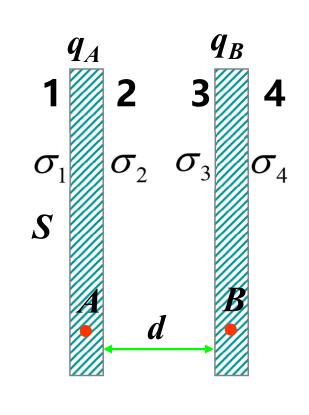
解 如图示,设4个表面的电荷面密度分别 为 σ_1 , σ_2 , σ_3 , σ_4 ,则

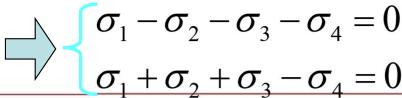
$$\sigma_1 S + \sigma_2 S = q_A, \quad \sigma_3 S + \sigma_4 S = q_B \quad \textcircled{1}$$

在两板内分别取任意两点A和B,则

$$E_{A} = \frac{\sigma_{1}}{2\varepsilon_{0}} - \frac{\sigma_{2}}{2\varepsilon_{0}} - \frac{\sigma_{3}}{2\varepsilon_{0}} - \frac{\sigma_{4}}{2\varepsilon_{0}} = 0$$

$$E_{B} = \frac{\sigma_{1}}{2\varepsilon_{0}} + \frac{\sigma_{2}}{2\varepsilon_{0}} + \frac{\sigma_{3}}{2\varepsilon_{0}} - \frac{\sigma_{4}}{2\varepsilon_{0}} = 0$$





例 两块等面积的金属平板 ,分别带电荷 q_A 和 q_B ,平板面积均 为S,两板间距为d,且满足面积的线度远大于d。

求 静电平衡时两金属板各表面上的电荷面密度。

$$\sigma_1 = \sigma_4, \quad \sigma_2 = -\sigma_3$$

代入①,得
$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{q_A + q_B}{2S}$$

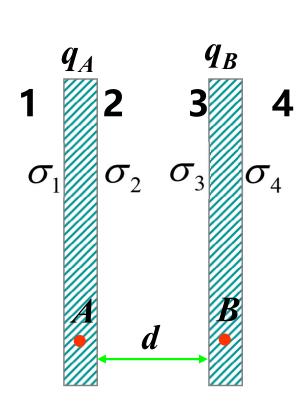
$$\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{q_A - q_B}{2S}$$

可见, A、B 两板的内侧面带等量异号 电荷:两板的外侧面带等量同号电荷。

◆ 特别地,若 q_A = - q_B = q ,则

$$\sigma_1 = \sigma_4 = 0$$
 $\sigma_2 = -\sigma_3 = q/S$

电荷只分布在两板的内侧面,外侧面不带电。



例 半径为 R_1 的金属球A带电为q (>0),在它外面有一同心放置的金属球壳B,其内外半径分别为 R_2 和 R_3 ,带电为 Q (>0)。如图所示,当此系统达到静电平衡时,

求 (1) 各表面上的电荷分布;

- (2) 电场强度分布;
- (3) 电势分布及球A与球壳B的电势差。

解 (1) 电量分布

球 A: 根据对称性, 电量均匀分布在 球 A 的表面上, 电量为 q。

球壳 B: 由于静电感应, 球壳B内表面的电量为: -q; 外表面的电量为: Q+q。

B

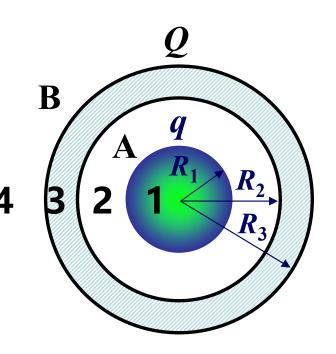
整个系统相当于在真空中的三个均匀带电的球面。

例 半径为 R_1 的金属球A带电为q (>0),在它外面有一同心放置的金属球壳B,其内外半径分别为 R_2 和 R_3 ,带电为 Q (>0)。如图所示,当此系统达到静电平衡时,

(2) 电场强度分布

由高斯定理及静电平衡条件,得

$$\begin{cases} E_{1} = 0 & (r < R_{1}) \\ E_{2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}} & (R_{1} < r < R_{2}) \\ E_{3} = 0 & (R_{2} < r < R_{3}) \\ E_{4} = \frac{q + Q}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}} & (R_{3} < r) \end{cases}$$

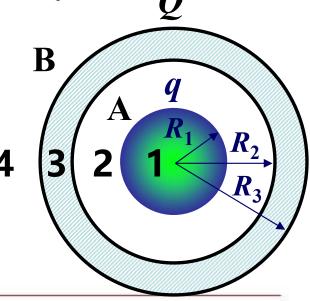


例 半径为 R_1 的金属球A带电为q (>0),在它外面有一同心放置的金属球壳B,其内外半径分别为 R_2 和 R_3 ,带电为 Q (>0)。如图所示,当此系统达到静电平衡时,

(3)电势分布

取无穷远为电势零点,半径为R,电量为q 的均匀带电球壳的电势分布为

$$V_{\text{ph}} = rac{q}{4\piarepsilon_0 r} \qquad V_{\text{ph}} = rac{q}{4\piarepsilon_0 R}$$



例 半径为 R_1 的金属球A带电为q(>0),在它外面有一同心放置 的金属球壳B, 其内外半径分别为 R_2 和 R_3 , 带电为 Q (>0)。 如图所示, 当此系统达到静电平衡时,

利用叠加原理,得

$$\begin{cases} V_{1} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \left(\frac{q}{R_{1}} - \frac{q}{R_{2}} + \frac{q + Q}{R_{3}} \right) & (r < R_{1}) \\ V_{2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \left(\frac{q}{r} - \frac{q}{R_{2}} + \frac{q + Q}{R_{3}} \right) & (R_{1} < r < R_{2}) \end{cases}$$

$$V_{3} = \frac{q + Q}{4\pi\varepsilon_{0}R_{3}}$$

$$V_{4} = \frac{q + Q}{4\pi\varepsilon_{0}r}$$

$$(R_{3} < r)$$

球A与球壳B的电势差为
$$U_{AB} = V_1 - V_3 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} (\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2})$$